

Электронный спиновый резонанс в твердых растворах замещения $\text{Eu}_{1-x}\text{Ca}_x\text{B}_6$ и $\text{Eu}_{1-x}\text{Gd}_x\text{B}_6$

Самарин А.Н.^{1,2}, Семено А.В.¹, Гильманов М.И.^{1,2},
Анисимов М.А.¹, Глушков В.В.^{1,2}, Демишев С.В.¹,
Левченко А.В.³, Филипов И.Б.³, Шицевалова Н.Ю.³

¹Институт общей физики им. А.М.Прохорова, ОНТИКТ, Москва

²Московский физико-технический институт, ФПФЭ, Долгопрудный

³Институт проблем материаловедения им. И.Францевича НАНУ, Киев

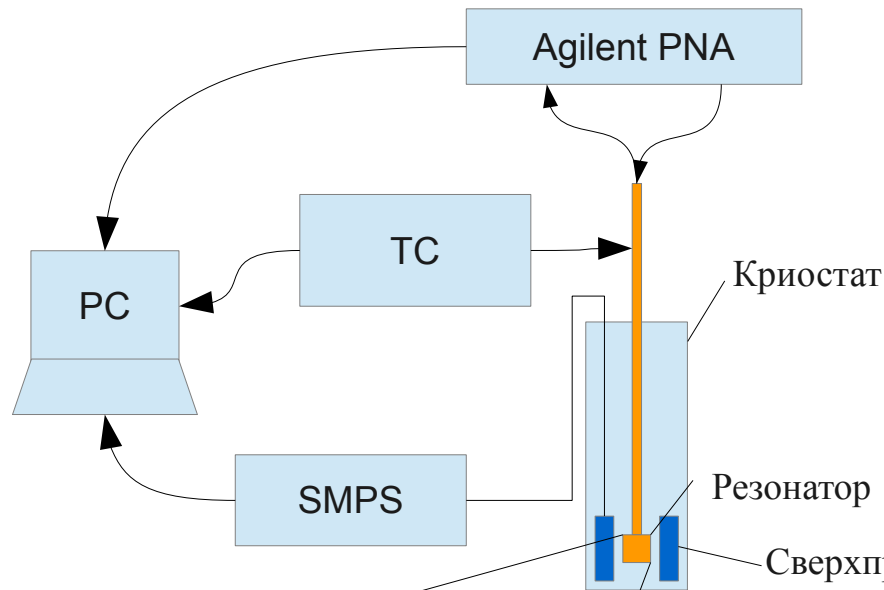


План доклада

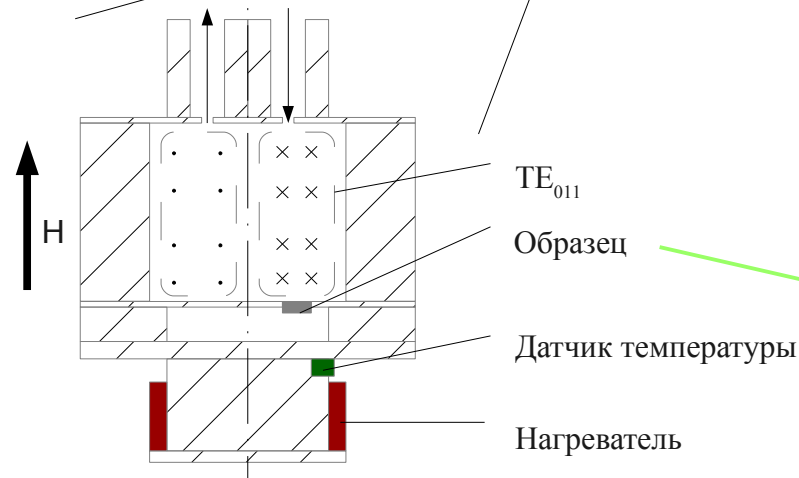
- Описание экспериментальной установки и методики измерений ЭСР в металлах с сильными электронными корреляциями
- Методика обработки и результаты исследования $\text{Eu}_{1-x}\text{Gd}_x\text{B}_6$
- Методика обработки и результаты исследования $\text{Eu}_{1-x}\text{Ca}_x\text{B}_6$
- Выводы



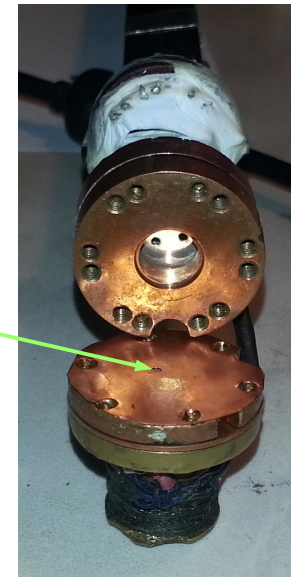
Схема экспериментальной установки и геометрия эксперимента



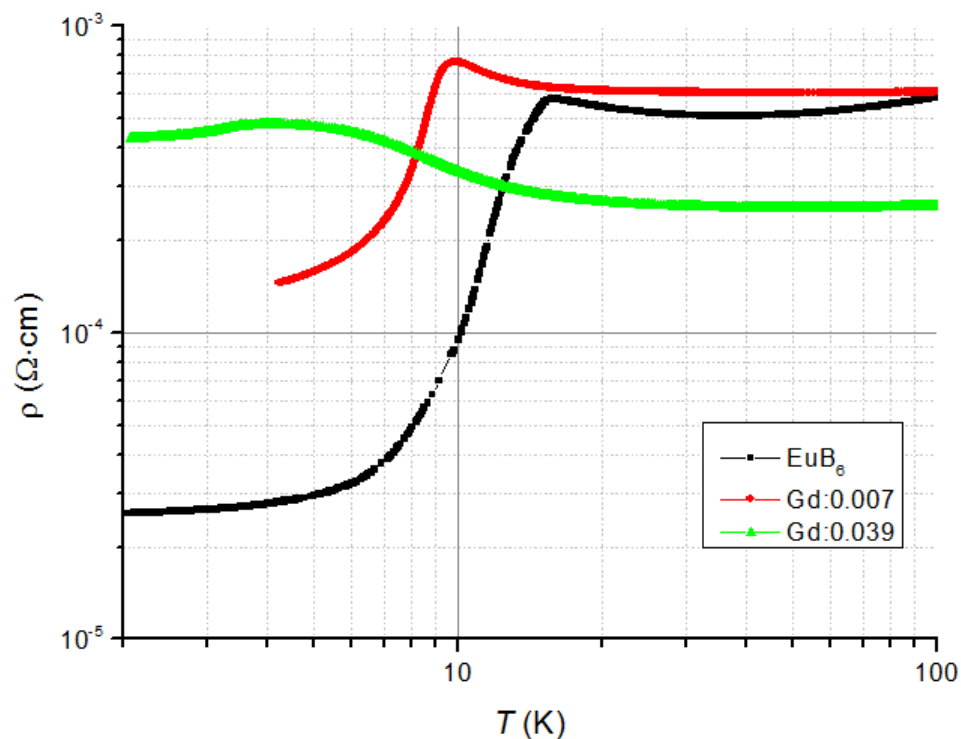
Agilent PNA E8361C — векторный анализатор цепей
 TC — температурный контроллер
 (Cryotel Model TC1.5/300 Temperature Controller)
 SMPS — источник тока сверхпроводящего магнита
 (Cryotel Model 100 SMPS)
 Напряженность магнитного поля: до 7 Тл
 Диапазон температур: 1.8 – 300 К
 Стабилизация температуры: **0.001К** при $T < 40\text{К}$
 Частота СВЧ-излучения: до 67 ГГц
 Отношение сигнал/шум: более 60 дБ



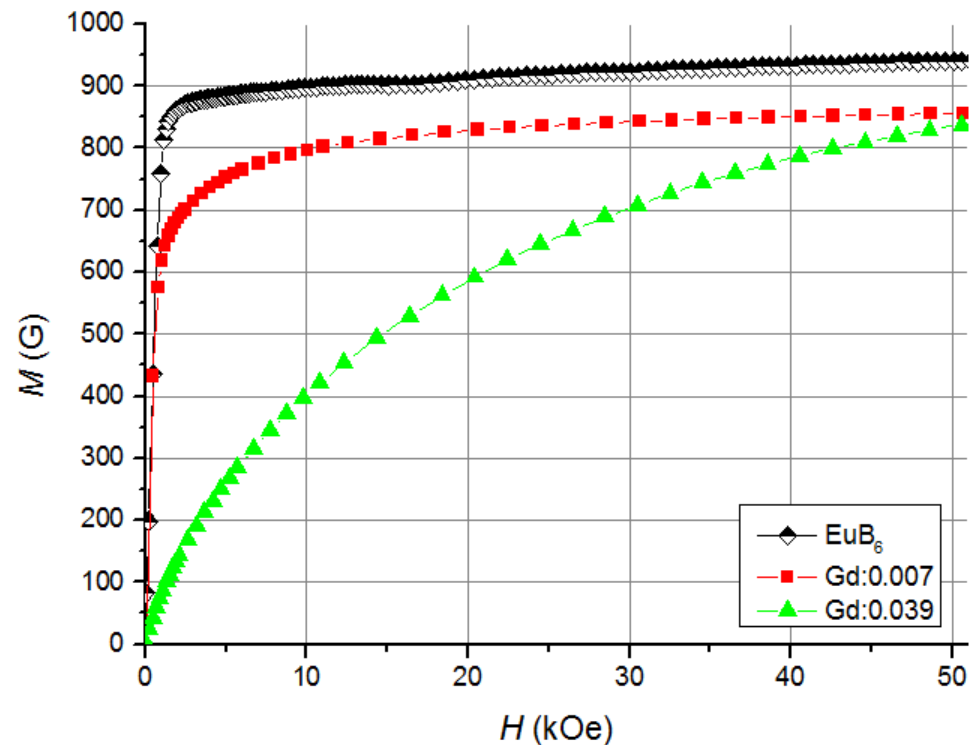
Основная рабочая мода – TE₀₁₁, частота – 60 ГГц



Статические свойства образцов $\text{Eu}_{1-x}\text{Gd}_x\text{B}_6$



Удельное сопротивление образцов EuB_6 и $\text{Eu}_{1-x}\text{Gd}_x\text{B}_6$, полученное из результатов измерений транспортных свойств (установка гальваномагнитных измерений ОНТикТ ИОФ РАН)



Статическая намагниченность образцов EuB_6 и $\text{Eu}_{1-x}\text{Gd}_x\text{B}_6$, полученная из результатов SQUID-измерений (MPMS-5, Quantum Design)



Методика абсолютной калибровки кривых поглощения ЭСР

Общее решение уравнения движения намагниченности Ландау-Лифшица (модель локализованных магнитных моментов):

$$\vec{B} = \hat{\mu} \vec{H}$$

$$\hat{\mu} = \begin{vmatrix} \mu_0 & i\mu_a & 0 \\ -i\mu_a & \mu_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \mu_0 + \mu_a &= \mu_1^+ - i\mu_2^+ \\ \mu_0 - \mu_a &= \mu_1^- - i\mu_2^- \end{aligned}$$

$$\mu_1^+ = 1 + 4\pi \frac{\gamma M_0 ((1 + \alpha^2)\omega_0 - \omega)}{(\omega_0 - \omega)^2 + \alpha^2 \omega_0^2}$$

$$\mu_1^- = 1 + 4\pi \frac{\gamma M_0 ((1 + \alpha^2)\omega_0 + \omega)}{(\omega_0 + \omega)^2 + \alpha^2 \omega_0^2}$$

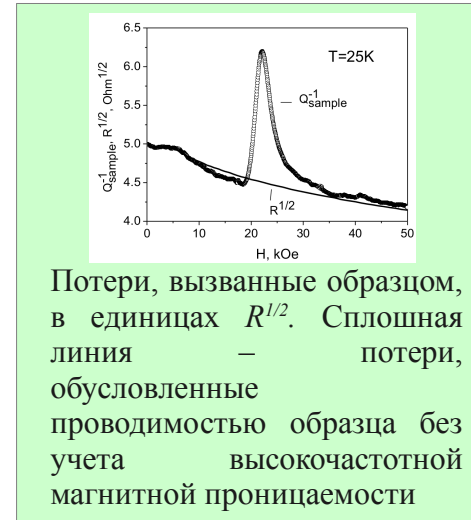
$$\mu_2^+ = 4\pi \frac{\gamma M_0 \alpha \omega}{(\omega_0 - \omega)^2 + \alpha^2 \omega_0^2}$$

$$\mu_2^- = 4\pi \frac{\gamma M_0 \alpha \omega}{(\omega_0 + \omega)^2 + \alpha^2 \omega_0^2}$$

$$\begin{aligned} Q^{-1} &= Q_{res}^{-1} + Q_{sample}^{-1} \\ Q_{sample}^{-1} &\sim \Re \left[i \frac{\mu}{\sigma} \right]^{1/2} \\ \mu &= 1 + 4\pi \chi \\ \mu &= \mu_1 - i\mu_2 \\ \chi &= \chi_1 - i\chi_2 \end{aligned}$$

- Q — добротность нагруженного резонатора
- Q_{res} — добротность ненагруженного резонатора
- Q_{sample} — потери, вносимые образцом
- μ — высокочастотная магнитная проницаемость
- σ — комплексная проводимость образца

- ω — частота СВЧ колебаний
- α — коэффициент диссипации
- g — g-фактор
- M_0 — осциллирующая намагниченность
- γ — гиромагнитное соотношение
- N_z — размагничивающий фактор
- M — статическая намагниченность
- H — напряженность внешнего магнитного поля



$$\gamma = g \frac{\mu_B}{\hbar}$$

$$\omega_0 = \gamma (H - 4\pi N_z M)$$

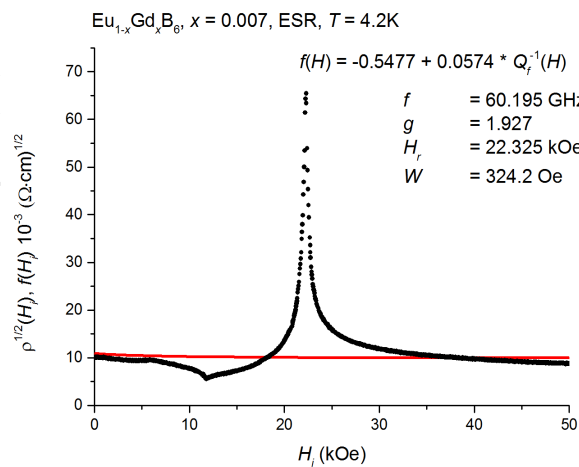
$$Q_{sample}^{-1} \sim \frac{1}{2} \left[\sqrt{\sqrt{\mu_1^{+2} + \mu_2^{+2}} + \mu_2^+} + \sqrt{\sqrt{\mu_1^{-2} + \mu_2^{-2}} + \mu_2^-} \right]$$

A.V. Semeno, et al., Phys. Rev. B, 79, 014423 (2009)
J. Young and E. Uehling, Phys. Rev. 94, 544 (1954)

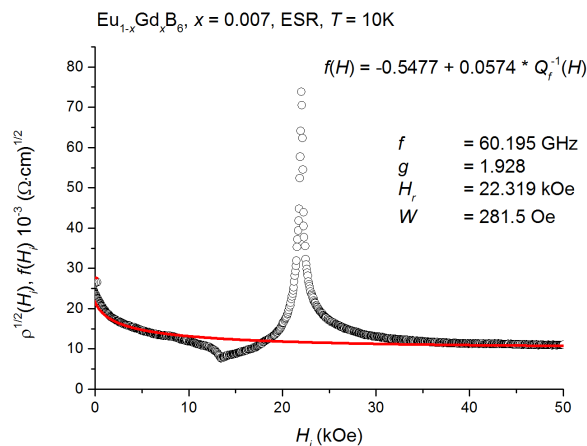


ЭСР в $\text{Eu}_{1-x}\text{Gd}_x\text{B}_6$ ($x = 0.007$)

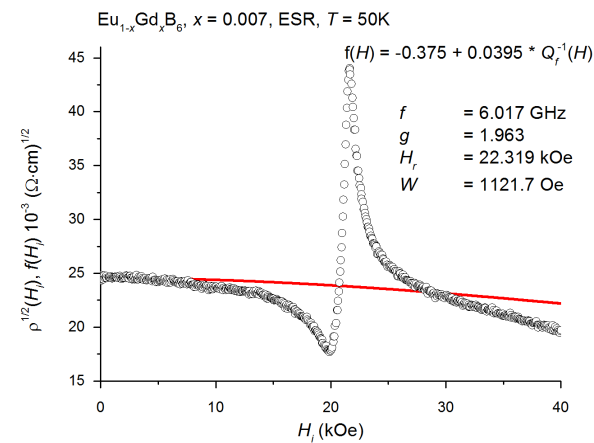
Поглощение, $\rho^{1/2}(\text{H})$



T = 4.2K

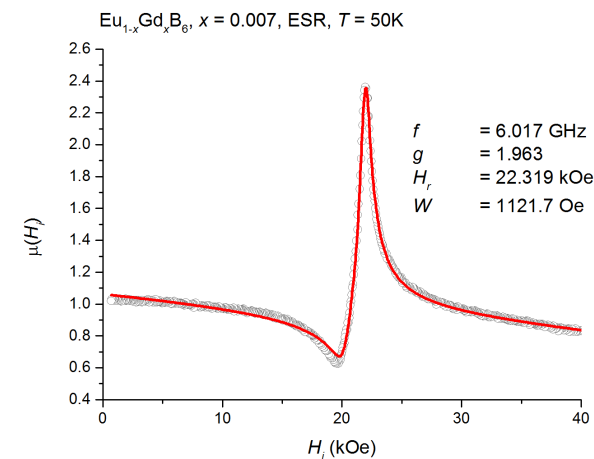
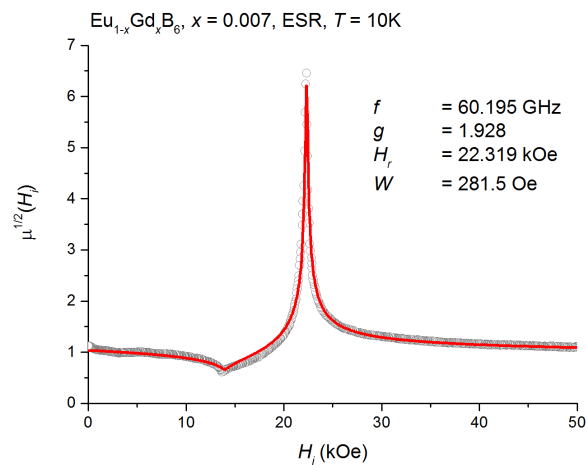
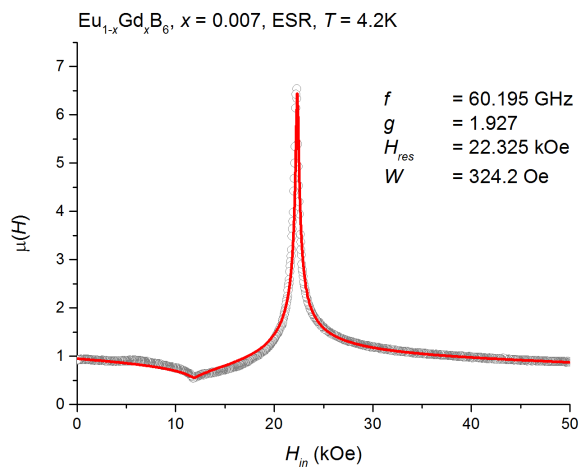


T = 15K



T = 50K

ВЧ м.проницаемость, fits



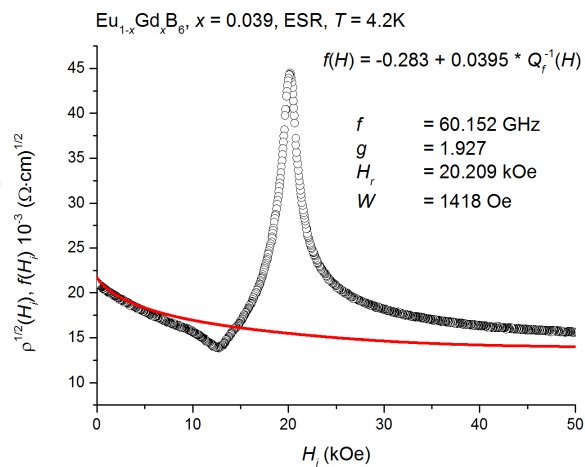
Черные точки соответствуют экспериментальным кривым,
красные линии – аппроксимация экспериментальных кривых модельной функцией.

Параметры аппроксимации: α , g , M_0

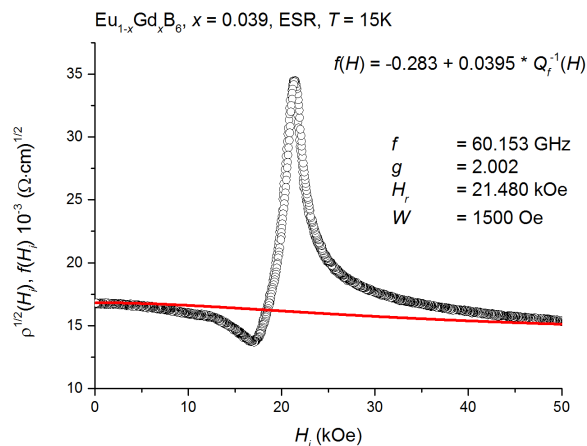


ЭСР в $\text{Eu}_{1-x}\text{Gd}_x\text{B}_6$ ($x = 0.039$)

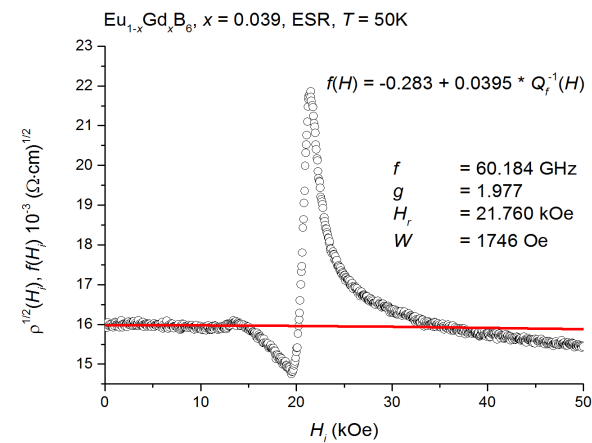
Поглощение, $\rho^{1/2}(\text{H})$



T = 4.2K

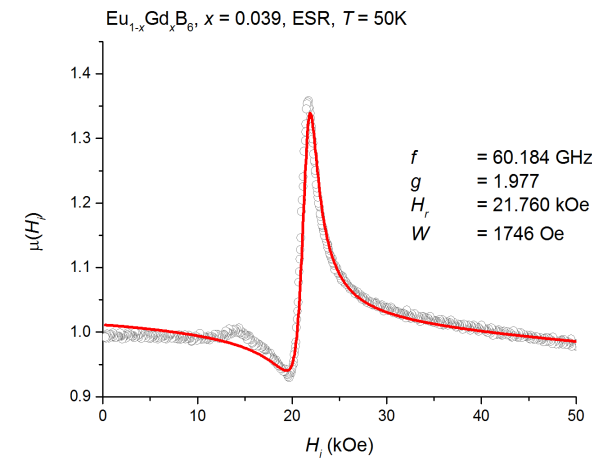
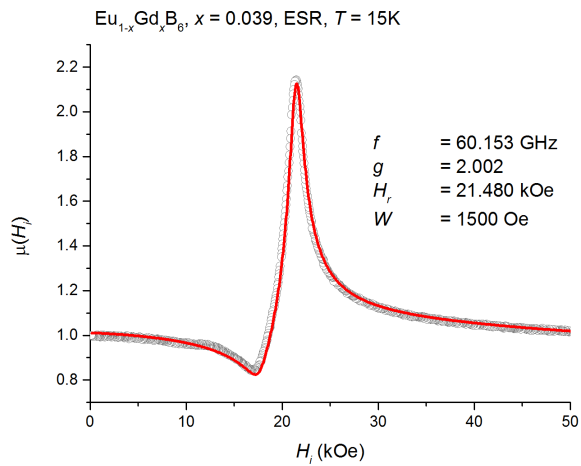
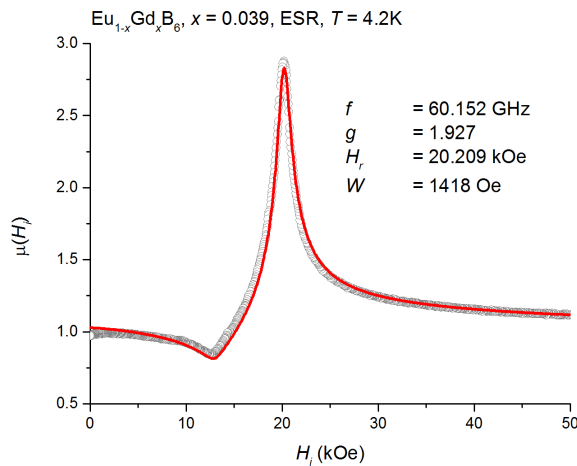


T = 15K



T = 50K

ВЧ м.проницаемость, fits

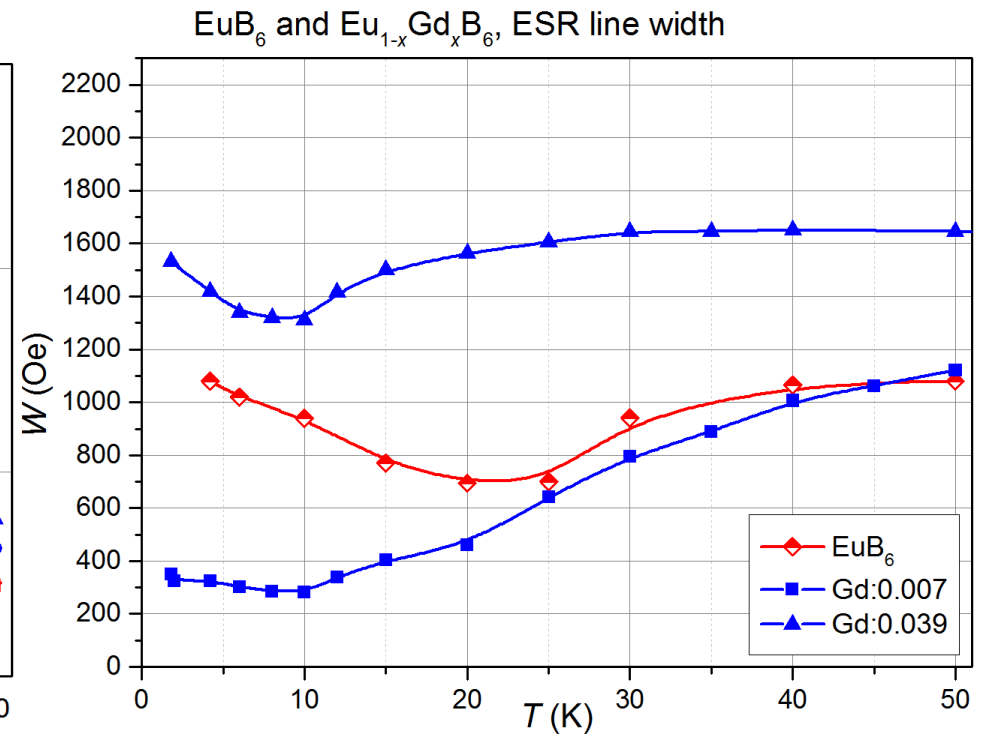
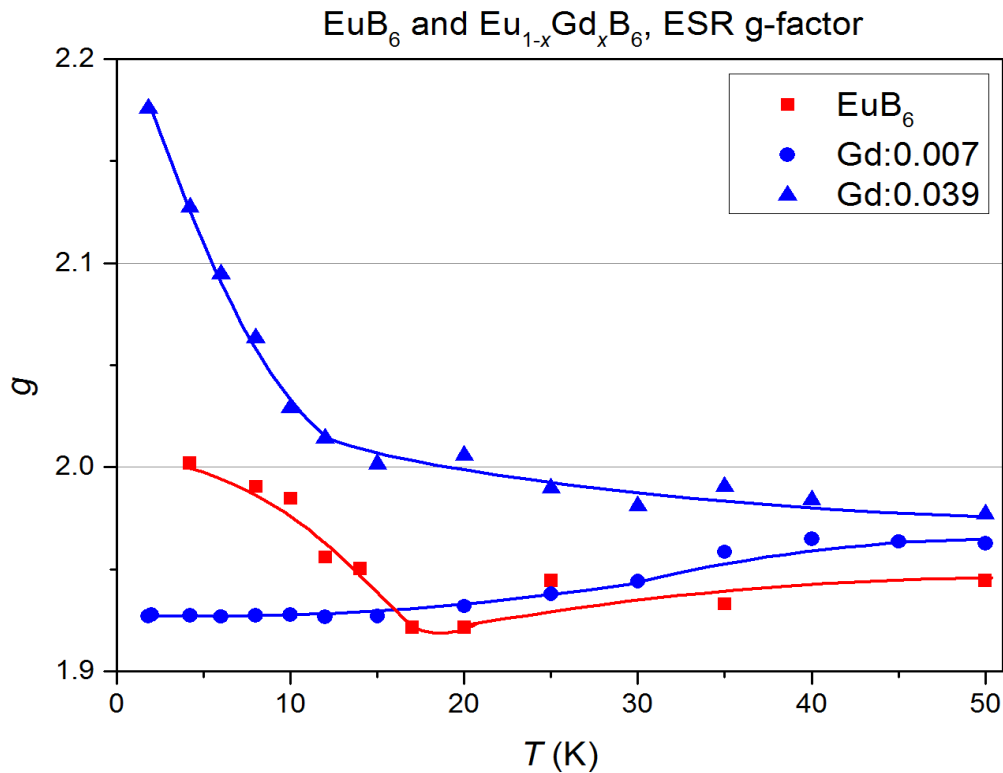


Черные точки соответствуют экспериментальным кривым, красные линии – аппроксимация экспериментальных кривых модельной функцией.

Параметры аппроксимации: α , g , M_0



Температурные зависимости параметров линии ЭСР в $\text{Eu}_{1-x}\text{Gd}_x\text{B}_6$

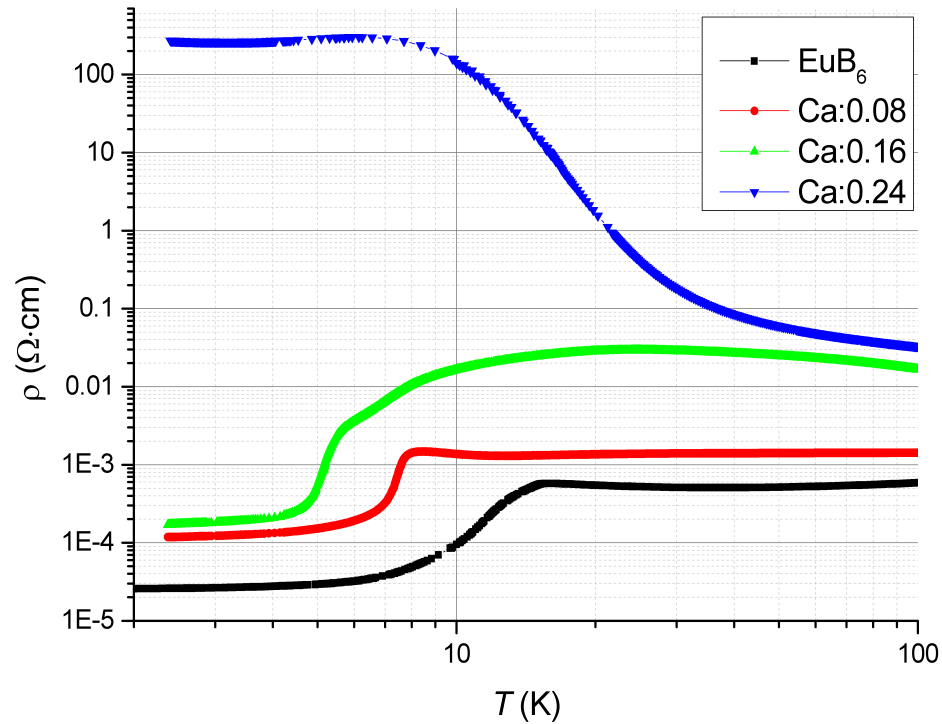


Линейную температурную зависимость $W(T)$ в парамагнитной области ($T > T_c$) можно объяснить корринговским механизмом рассеяния [1].

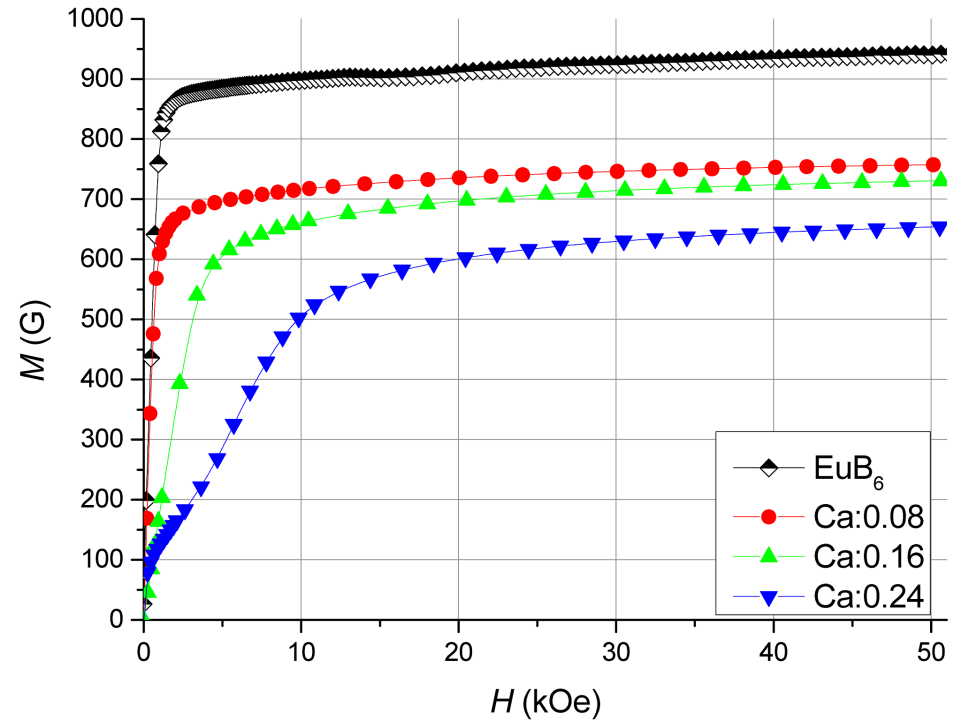
[1] S.E.Barnes, Advances in Physics, 30, 801 (1981)



Статические свойства образцов $\text{Eu}_{1-x}\text{Ca}_x\text{B}_6$



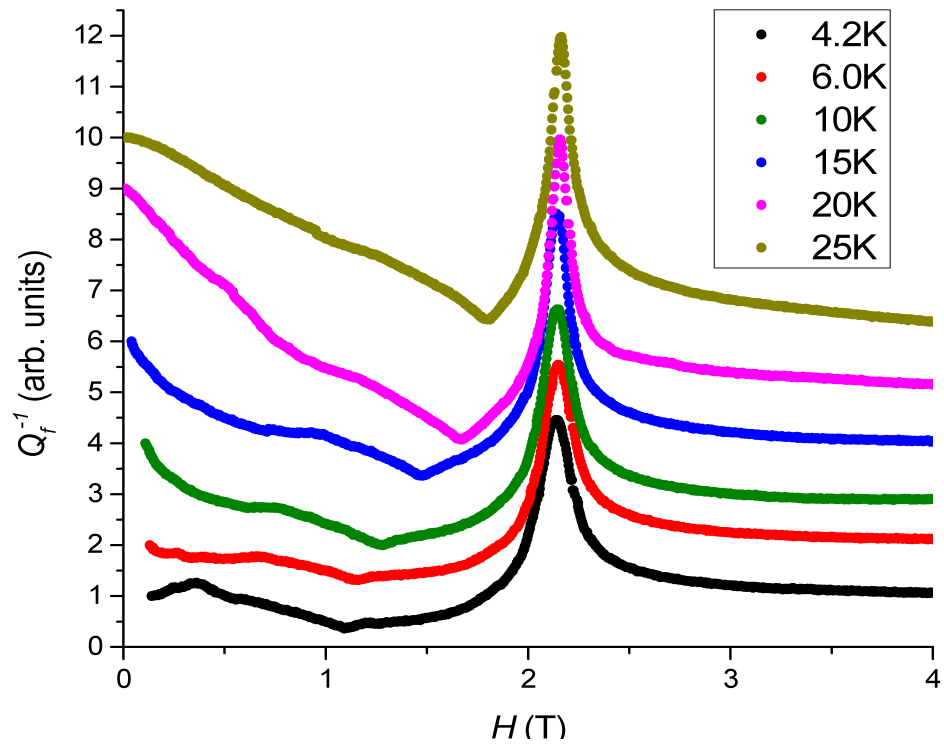
Удельное сопротивление образцов EuB_6 и $\text{Eu}_{1-x}\text{Ca}_x\text{B}_6$, полученное из результатов измерений транспортных свойств (установка гальваномагнитных измерений ОНТикТ ИОФ РАН)



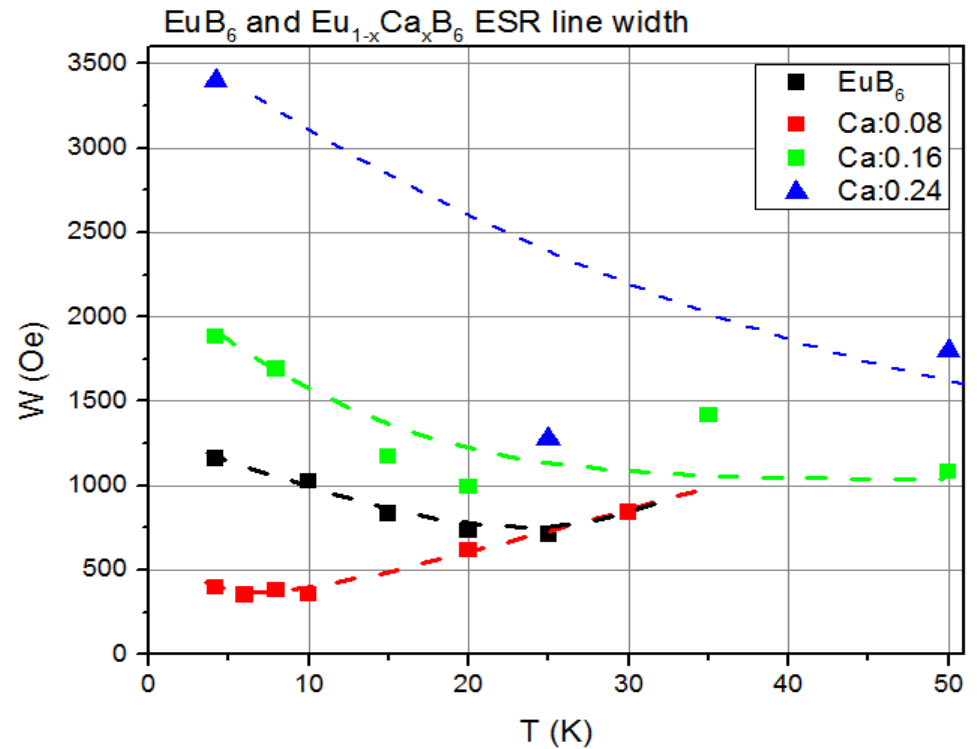
Статическая намагниченность образцов EuB_6 и $\text{Eu}_{1-x}\text{Ca}_x\text{B}_6$, полученная из результатов SQUID-измерений (MPMS-5, Quantum Design)



Применение стандартной методики к $\text{Eu}_{1-x}\text{Ca}_x\text{B}_6$



Исходные кривые резонансного поглощения в EuB_6 .
Все кривые сдвинуты для наглядности.



Температурные зависимости ширины
линии ЭСР $W(T)$ в EuB_6 и $\text{Eu}_{1-x}\text{Ca}_x\text{B}_6$.

g -фактор примерно постоянен: $g \sim 1.95 \pm 0.05$

Учет комплексной проводимости в $\text{Eu}_{1-x}\text{Ca}_x\text{B}_6$

В $\text{Eu}_{1-x}\text{Ca}_x\text{B}_6$ существенен вклад мнимой части комплексной проводимости.

Модель Götze, Wölfle
[Phys.Rev.B 6, 1226 (1972)]

$$M(\omega) = M'(\omega) + i M''(\omega) \quad \leftarrow \text{Функция памяти}$$

$$\sigma(\omega) = \frac{e^2 N}{m} \cdot \frac{i(\omega + M'(\omega)) + M''(\omega)}{(\omega + M'(\omega))^2 + (M''(\omega))^2}$$

Общие свойства:

$$M'(\omega) = -M'(-\omega)$$

$$M''(\omega) = M''(-\omega)$$

Минимальное
предположение

$$M'(\omega) \approx M'(0) + \frac{\partial M'}{\partial \omega} \cdot \omega + \dots \quad \rightarrow \quad M'(0) = 0$$

$$M''(\omega) \approx M''(0)$$

$$\sigma(\omega) = \frac{e^2 N}{m} \cdot \frac{i\omega \left(1 + \frac{\partial M'}{\partial \omega}\right) + M''(0)}{\left[\omega \left(1 + \frac{\partial M'}{\partial \omega}\right)\right]^2 + (M''(0))^2}$$

Выбор функции $\sigma(\omega, H)$:

$\sigma(0, H)$ – DC магнитосопротивление
(известно из эксперимента)

$\sigma(0, 0)$ – DC проводимость в нулевом поле

Предположение:

$$\sigma(\omega=0) = \sigma(0, H) = \frac{e^2 N}{m M''(0)}$$

$$M''(0) = \frac{e^2 N}{m \sigma(0, H)}$$



Учет комплексной проводимости в $Eu_{1-x}Ca_xB_6$

$$\sigma(\omega, H) = \sigma(0, H) \cdot \frac{i\omega \left(1 + \frac{\partial M'}{\partial \omega}\right) \cdot \frac{m\sigma(0, H)}{e^2 N} + 1}{\left[\omega \left(1 + \frac{\partial M'}{\partial \omega}\right) \cdot \frac{m\sigma(0, H)}{e^2 N}\right]^2 + 1}$$

Выделяем полевой вклад:

$$\frac{1 + \frac{\partial M'}{\partial \omega}}{e^2 N} \cdot m\sigma(0, H) \equiv \frac{1 + \frac{\partial M'}{\partial \omega}}{e^2 N} \cdot m\sigma(0, 0) \cdot \frac{\sigma(0, H)}{\sigma(0, 0)} = \tau(T, \omega) \cdot \frac{\sigma_T(0, H)}{\sigma_T(0, 0)}$$

$$\tau(T, \omega) = \frac{\sigma(0, 0)}{e^2 N/m} \left(1 + \frac{\partial M'}{\partial \omega}\right)$$



В общем случае – функция температуры и частоты. В минимальном приближении не имеет частотной зависимости.

Итоговое выражение для проводимости:

$$\sigma(\omega, H, T) = \sigma_{DC}(H) \cdot \frac{i\omega \tau(T) \frac{\sigma_{DC}(H)}{\sigma_{DC}(0)} + 1}{\left[\omega \tau(T) \frac{\sigma_{DC}(H)}{\sigma_{DC}(0)}\right]^2 + 1}$$

Выражение для аппроксимации экспериментальных кривых:

$$Q_{sample}^{-1} \sim \Re \left[i\omega \frac{(\mu + \mu_a)}{\sigma} \right]^{1/2} + \Re \left[i\omega \frac{(\mu - \mu_a)}{\sigma} \right]^{1/2}$$

$$\mu \pm \mu_a = \mu_1^\pm - i\mu_2^\pm$$

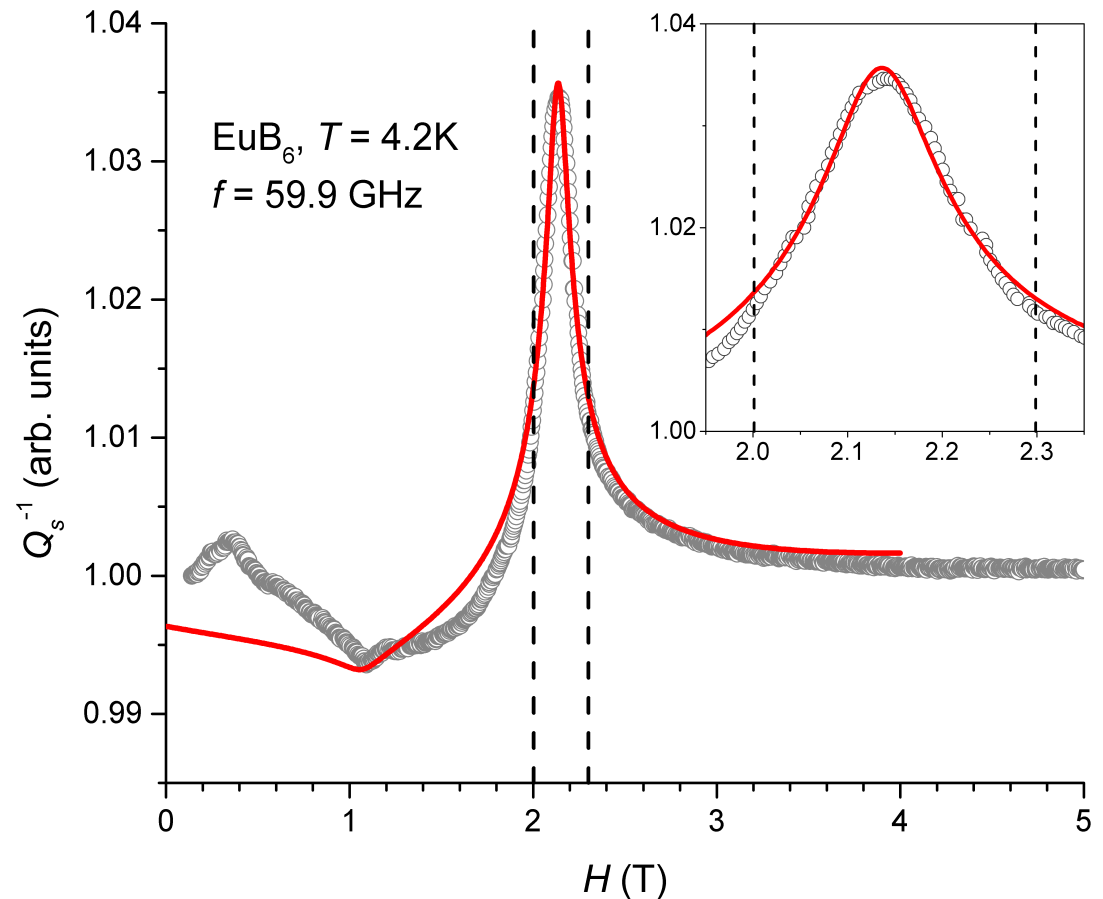


Алгоритм обработки экспериментальных данных в $\text{Eu}_{1-x}\text{Ca}_x\text{B}_6$

Аппроксимация производится в два этапа.

На первом этапе задействована вся экспериментальная кривая, при аппроксимации подбирается осциллирующая намагниченность M_0 , g-фактор и оценивается ширина линии.

На втором этапе M_0 и g-фактор фиксируются и в узкой области резонанса подбирается ширина линии (или время спиновой релаксации) и время транспортной релаксации.

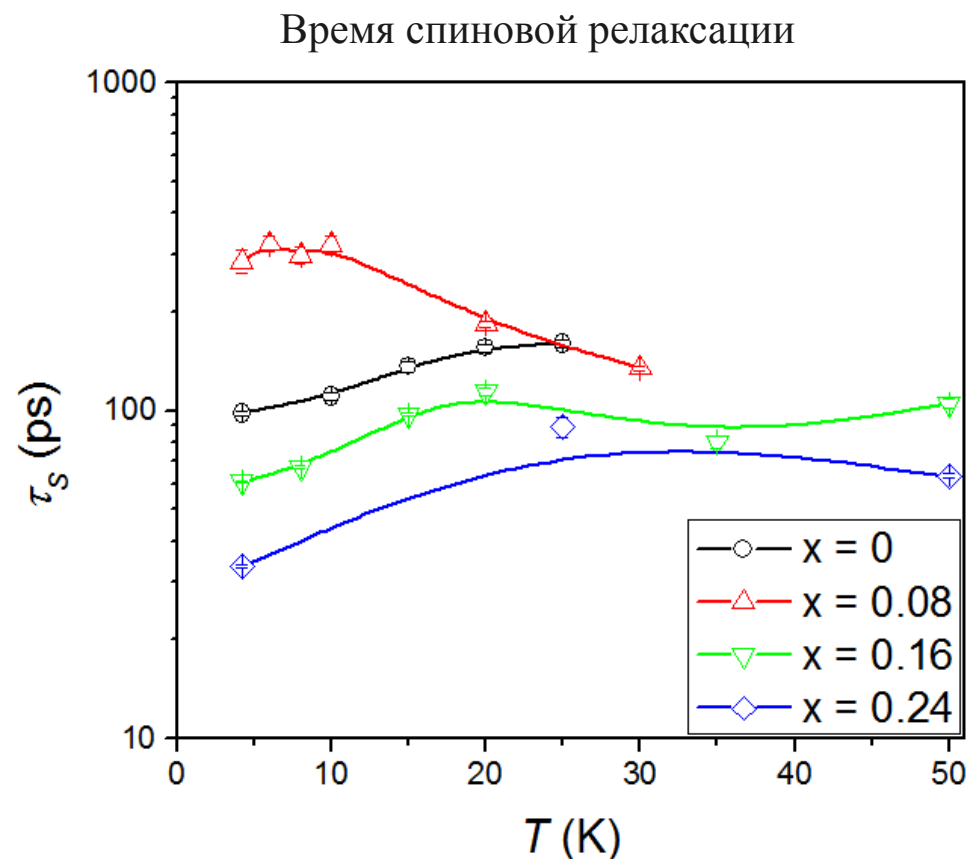
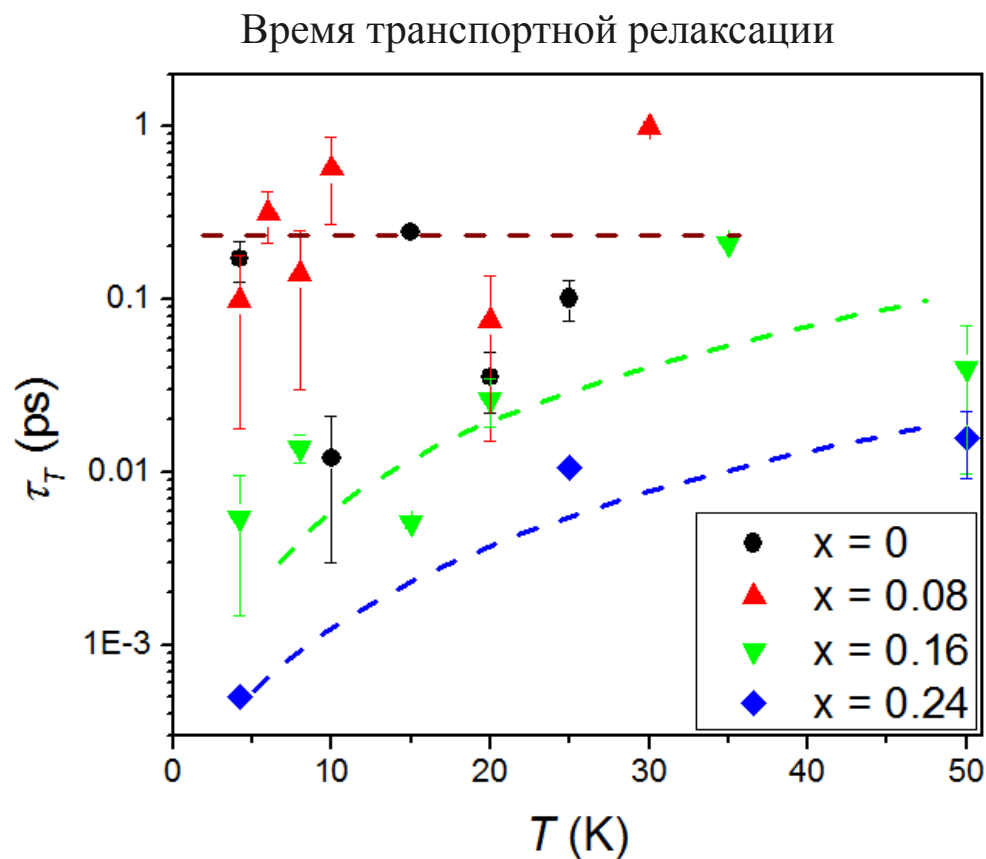


Серые точки соответствуют экспериментальным кривым, красные линии – аппроксимация экспериментальных кривых модельной функцией.

Параметры аппроксимации: α , g , M_0 , τ



Времена релаксации $\text{Eu}_{1-x}\text{Ca}_x\text{B}_6$



Все образцы исследованы на частоте **60 ГГц**.



Выводы

- Было произведено исследование электронного спинового резонанса в системах $\text{Eu}_{1-x}\text{Ca}_x\text{V}_6$ ($x < 0.25$) и $\text{Eu}_{1-x}\text{Gd}_x\text{V}_6$ ($x < 0.05$) в полях до 7 Т при температурах от 1.8 К до 50 К. Обнаружена немонотонная во всем диапазоне концентраций температурная зависимость ширины линии ЭСР $W(T)$.
- В парамагнитной фазе ($T > T_c$) видна линейная температурная зависимость $W(T)$. В магнитоупорядоченной фазе ($T < T_c$) наблюдается дополнительный механизм микроволновых потерь, приводящий к увеличению ширины линии ЭСР с понижением температуры.
- Увеличение концентрации примеси (до $x \sim 0.1$ для Са и $x \sim 0.01$ для Gd) приводит к подавлению этого механизма. Дальнейшее увеличение концентрации еще сильнее увеличивает ширину линии во всем температурном диапазоне. Выяснение природы наблюдаемого эффекта требует проведения дополнительных исследований соединений на основе EuV_6 .
- Разработана методика определения транспортного времени релаксации из ЭСР-эксперимента. Произведены оцененки времен спиновой и транспортной релаксации в системе $\text{Eu}_{1-x}\text{Ca}_x\text{V}_6$.

Работа поддержана грантом РФФИ 13-02-00160 и программами РАН «Электронный спиновый резонанс, спин-зависимые электронные эффекты и спиновые технологии» и «Электронные корреляции в системах с сильным взаимодействием».

